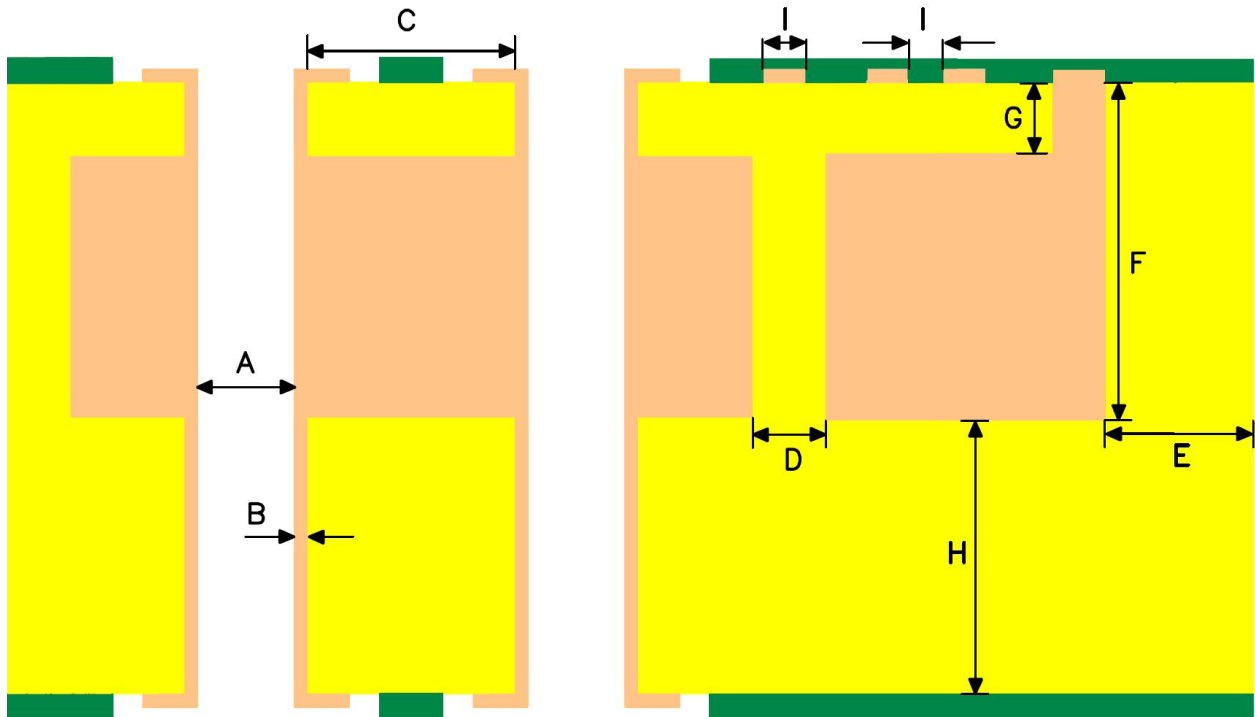


Symbol	Parameter	Wert
A	Leiterplattenstärke (Toleranz +- 10%)	0,20 - 4,50 mm
B	Minimale Kernstärke ohne Buried Vias	0,10 mm
C	Minimale Kernstärke mit Buried Vias	0,20 mm
D	CU-Schichtdicke Außenlagen	35 µm – 435 µm
E	CU-Schichtdicke Innenlagen	18 µm – 400 µm
F	CU-Schichtdicke Bohrungshülse	> 20 µm
G	CU-Schichtdicke Anbindungen Blind Vias	> 17 µm
H	CU-Schichtdicke Buried Vias	> 20 µm
I	Leiterbahnbreite / Leiterbahnabstand für Außen- und Innenlagen	
	18µ Grundkupfer	100 µm / 100 µm
	35µ Grundkupfer	120 µm / 120 µm
	70µ Grundkupfer	150 µm / 150 µm
	105µ Grundkupfer (Siehe Zg. Ätzcharakteristik)	250 µm / 250 µm
	210µ Grundkupfer (Siehe Zg. Ätzcharakteristik)	500 µm / 500 µm
J	Minimaler Bohrendurchmesser durchgehender Bohrungen	0,15 mm
	Aspekt Ratio LP-Dicke zu Bohrendurchmesser	6 : 1
K	Minimaler Bohrendurchmesser Blind Vias	0,15 mm
	Aspekt Ratio Bohrendurchmesser zu Bohrtiefe	1 : 1
L	Minimaler Bohrendurchmesser Buried Vias	0,15 mm
	Aspekt Ratio LP-Dicke zu Bohrendurchmesser	6 : 1
M	Restringbreite umlaufend	0,15 mm
N	Minimale Stegbreite Lötstopplack	100 µm
O	Minimale Lötstopplackfreistellung	50 µm
P	Minimale Kantendeckung Lötstopplack	> 8 µm
Q	Dicke Lötstopplack	> 20 µm
R	Abstand Leiter zu LP-Rand fräsen / ritzen	0,30 mm / 0,50 mm



Symbol	Parameter für Kupferinlaytechnik	Wert
A	Minimaler Bohrendurchmesser	0,70 mm
B	CU-Schichtdicke Bohrungshülse	> 20 μm
C	Bohrlochabstand	> 0,20 mm
D	Minimaler Abstand zwischen Kupferinlayteilen	> 2,00 mm
E	Abstand LP-Rand zu Kupferinlayteilen	0,00 μm
F	Gesamtdicke Kupferinlayteile	0,50 mm – 2,00 mm
G	Höckerhöhe	> 0,20 mm
H	Isolation auf Kupferinlayteil	> 0,20 mm

Ätzcharakteristik:

